

ДП КВАЗАР-ІС

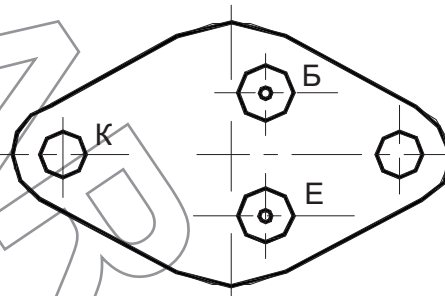
ЕТИКЕТКА

Транзистори: 2Т825А КК,
2Т825Б КК, 2Т825В КК.

Коди маркування: 2Т825А КК -
2Т825А, 2Т825Б КК - 2Т825Б,
2Т825В КК - 2Т825В.

Кремнієві меза-планарні р-п-р потужні транзистори 2Т825А КК, 2Т825Б КК, 2Т825В КК в металоскляному корпусі КТ-9. Застосовуються в підсилювачах потужності, повторювачах, перемикачах, в електронних системах управління, захисту та автоматики радіоелектронної апаратури загального призначення, що працює в нормальних та складних кліматичних умовах.

Схема розташування виводів



Маса транзистора
не більше 20 г.

ОСНОВНІ ЕЛЕКТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ КОРПУСУ (25 ± 10) °С

№ п/п	Назва параметру, одиниця вимірювання (режим вимірювання)	Символ	Норма					
			2Т825А КК		2Т825Б КК		2Т825В КК	
			не менше	не більше	не менше	не більше	не менше	не більше
1.	Статичний коефіцієнт передачі струму ($U_{КБ} = 10 \text{ В}$, $I_E = 10 \text{ А}$)	h_{21E}	500	18000	750	18000	750	18000
2.	Напруга насичення колектор-емітер, В ($I_K = 10 \text{ А}$, $I_B = 40 \text{ мА}$)	$U_{КЕ \text{ нас}}$	-	2	-	2	-	2
3.	Напруга насичення база- емітер, В ($I_K = 10 \text{ А}$, $I_B = 40 \text{ мА}$)	$U_{БЕ \text{ нас}}$	-	3	-	3	-	3
4.	Пробивна напруга колектор-емітер, В ($U_{БЕ} = 1,5 \text{ В}$, $I_K = 1 \text{ мА}$)	$U_{КЕ0 \text{ проб}}$	100	-	80	-	60	-
5.	Пробивна напруга емітер- база, В ($I_E = 2 \text{ мА}$)	$U_{ЕБ0 \text{ проб}}$	5	-	5	-	5	-
6.	Гранична напруга, В ($I_E = 100 \text{ мА}$, $Q \geq 100$, $t_u \leq 300 \text{ мкс}$)	$U_{КЕ0 \text{ гр}}$	80	-	60	-	45	-

Транзистори 2Т825А КК, 2Т825Б КК, 2Т825В КК відповідають технічним умовам КФУЛ.431500.007 ТУ.